**注意：**

1. 感谢您的参与！
2. 我们郑重承诺，您的个人信息以及工艺信息不会在未得到您的授权的情况下分享给任何第三方！
3. 我方提供的为免费技术支持，所提供信息仅为建议，仅供参考。如所涉及操作或者工艺与用户方安全、生态及制度管理等有冲突的地方，请按照贵司规定执行。我司不承担任何事故风险！

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | | |
| **\* 姓名：** |  |  | **单位：** |  |
| **\* 邮箱：** |  | **电话：** |  |
| **\* 问题类型：** |  | **\* 光刻类型：** |  |
| **<说明>** | 涂胶、曝光、显影、刻蚀/剥离、去胶或者其他问题 | **<说明>** | 接触式、激光直写、电子束直写、干涉光刻、其他光刻类型 |
| **光刻胶型号：** | 如：S1813 | **衬底类型：** | 如：InP衬底镀SiN薄膜 |
|  | | | | |
| **涂胶过程** | | | | |
| **预处理** | HMDS or 150℃，3min |  | **旋涂：** | 旋涂，4000rpm，60s |
| **<说明>** | 或其他处理，特别是涂胶出现问题时 | **<说明>** | 温度（22+/-1°C），湿度30-50%，如有偏离，请备注！  如出现厚度严重偏大，请备注低速转速及时间。 |
| **前烘：** | 热板，85℃，3min |
| **涂胶问题描述：** | 无异常 | | | |
|  | | | | |
| **曝光过程** | | | | |
| **再吸水** | ～1h |  | **曝光剂量：** | 60mJ/cm2 or 100uc/cm2 @100kV |
| **曝光异常描述：** | 无异常 | | | |
|  | | | | |
| **显影过程** | | | | |
| **显影方式：** | 浸没 |  | **显影液：** | 如：CD-26 |
| **<说明>** | 浸没、搅拌、喷淋 | **<说明>** | 如有稀释，或者自行配置，请告知配比 |
| **显影条件：** | 室温，45s | **定影/冲洗：** | DI -Water 30s 冲洗 or IPA冲洗30s |
| **显影问题描述：** | 无异常 | | | |
|  | | | | |
| **刻蚀/剥离过程** | | | | |
| **刻蚀/剥离：** | 剥离、干法刻蚀、湿法刻蚀 |  | **刻蚀条件** | 刻蚀时间，刻蚀气氛，刻蚀深度 |
| **<说明>** | 请选择其中一种 | **<说明>** | 请填写刻蚀条件，包括湿法刻蚀的刻蚀液种类及浓度信息。 |
| **剥离材料：** | Ti/Au，80nm | **镀膜方式** | 电子束蒸发、热蒸发、磁控溅射、ALD、CVD等 |
| **<说明>** | 请明确剥离材料的种类，厚度！ | **<说明>** | 镀膜方式对于剥离成功非常重要，必须填写。 |
| **刻蚀/剥离问题描述：** | 无异常 | | | |
|  | | | | |
| **去胶过程** | | | | |
| **请选择去胶方式：** | 湿法去胶、干法去胶 |  | **去胶液：** | 丙酮（温度？超声？） |
| **去胶问题描述：** | 无异常 | | | |
|  | | | | |
| **其他过程** | | | | |
| **您的问题描述：** | 无异常 | | | |
| **请描述您的特殊工艺过程及参数：** | 请描述您的特殊工艺信息 | | | |
|  | | | | |
| **图片信息** | | | | |
| **请上传图片：**  可多张，如文件过大，请打包图片转邮件发送 |  | | | |
| **图片描述：** | 图中…… | | | |
| **问题出现频次：** | （\*）首次且偶然发生 |（ ）最近一直有问题 |（ ）之前发生过类似问题 | | | |

注：请尽可能详细填写，有助于您自己梳理工艺步骤，也能使我们快速定位问题并分析出现问题的原因。谢谢！

日期：2023/4/13

1.（\*推荐\*）您可以通过以下链接提交本文档：<http://sup.prlib.cn/upload-q-file/>

1. 您也可以通过发送邮件至：[prlibteam@163.com](mailto:prlibteam@163.com?subject=问题反馈%20-%20日期)提交文件